



(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

identified phase component, and outputs a result based on the standardized phase component of the characteristic signal.

(57) 要約: 半導体検査装置1は、半導体デバイスSに対して電力を供給すると同時に半導体デバイスSの電力の供給に応じた電気特性を測定する測定器7と、複数の周波数で強度変調された光を半導体デバイスSに走査する光走査装置13と、光の走査に応じた複数の周波数成分の電気特性を示す特性信号を取得するロックインアンプ15と、特性信号を処理する検査装置19とを備え、検査装置19は、半導体デバイスSにおける第1層L1の電気特性が反映される走査位置の特性信号の位相成分を基準にして、任意の走査位置の特性信号の位相成分を補正し、半導体デバイスSにおける第2層L2の電気特性が反映される走査位置の特性信号の位相成分を特定し、当該位相成分を用いて任意の走査位置の特性信号の位相成分を規格化し、規格化された特性信号の位相成分に基づいた結果を出力する。